

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

訂正版

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年9月11日(11.09.2025)



(10) 国際公開番号

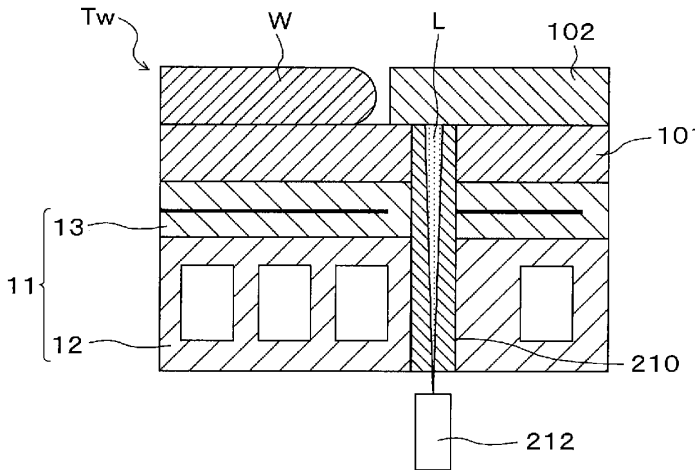
WO 2025/187421 A8

(51) 国際特許分類:
H01L 21/683 (2006.01) H01L 21/673 (2006.01)
H01L 21/31 (2006.01) H01L 21/3065 (2006.01)
(21) 国際出願番号: PCT/JP2025/005588
(22) 国際出願日: 2025年2月19日(19.02.2025)
(25) 国際出願の言語: 日本語
(26) 国際公開の言語: 日本語
(30) 優先権データ:
特願 2024-032821 2024年3月5日(05.03.2024) JP
(71) 出願人: 東京エレクトロン株式会社(TOKYO ELECTRON LIMITED) [JP/JP]; 〒1076325 東京都港区赤坂五丁目3番1号 (JP).

(72) 発明者: 喜多川 大 (KITAGAWA, Dai); 〒9813629 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ1番 東京エレクトロン宮城株式会社内 (JP). 照内 怜(TERUUCHI, Satoru); 〒9813629 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ1番 東京エレクトロン宮城株式会社内 (JP). 松本 直樹(MATSUMOTO, Naoki); 〒9813629 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ1番 東京エレクトロン宮城株式会社内 (JP). ▲瀬▼口 泰生(SEGUCHI, Taisei); 〒9813629 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ1番 東京エレクトロン宮城株式会社内 (JP). 佐藤 直紀(SATO, Naoki); 〒9813629 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ1番 東京エレクトロン宮城株式会社内 (JP). 伊藤 功英(ITO, Koei); 〒9813629 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ1番 東京エレクトロン宮城株式

(54) Title: SUBSTRATE TREATMENT DEVICE AND TRAY

(54) 発明の名称: 基板処理装置及びトレイ



(57) Abstract: Provided is a substrate treatment device that appropriately performs sheath control with respect to a substrate outer peripheral section and appropriately performs control of a consumption amount with respect to an annular part of a tray. The substrate treatment device for treating a substrate includes: a treatment chamber; and a support member disposed in the treatment chamber and including, on an upper surface, a tray support surface for supporting the tray. The tray includes a base part and a peripheral edge part forming a recess part that accommodates the substrate on an upper surface of the base part. The base part and the peripheral edge part are configured as separate bodies.

[続葉有]

WO 2025/187421 A8

会社内 (JP). 網倉 紀彦(AMIKURA, Norihiko);
〒9813629 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ 1
番 東京エレクトロン宮城株式会社内 (JP).

(74) 代理人: 金本 哲男, 外(KANEMOTO, Tetsuo et al.); 〒1620065 東京都新宿区住吉町 1 - 2 0 角張ビル 曙国際特許事務所 (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UY, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

(48) この訂正版の公開日:
2025年10月2日(02.10.2025)

(15) 訂正情報:
2025年10月2日(02.10.2025) の更新情報
(Notice) を参照

(57) 要約: 基板処理装置において基板外周部のシース制御を適切に行うと共に、トレイの円環部の消耗量の制御を適切に行う。基板を処理する基板処理装置であって、処理チャンバと、前記処理チャンバ内に配置され、上面にトレイを支持するトレイ支持面を有する支持部材と、を備え、前記トレイは、ベース部と、当該ベース部の上面に前記基板を収容する凹部を形成する周縁部と、を含み、前記ベース部と前記周縁部は、別体として構成される。